

Міністерство освіти і науки України  
Національна академія наук України  
Харківський національний університет радіоелектроніки  
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України  
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  
Інститут фізики НАН України  
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна  
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

**IX МІЖНАРОДНА  
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  
"Функціональна база наноелектроніки"**

18 - 23 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна

**Шановні колеги!**

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної наукової конференції "Функціональна база наноелектроніки", яка відбудеться у м. Одеса 18 - 23 вересня 2017 року.

Для участі у конференції запрошуюються: учені, експерти, фахівці, аспіранти, представники підприємств усіх форм власності, учбових закладів України та зарубіжжя.

**НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:**

- нові фундаментальні положення теорії та технології формування елементів наноелектроніки;
- наноматеріали та структури наноелектронної елементної бази;
- метаматеріали для наноелектроніки;
- скануючі зондові методи діагностики та технології у наноелектроніці;
- наноелектронні сенсори фізичних величин;
- нанобіологічні структури;
- наноелектроніка у мікросистемній техніці;
- фотоніка на основі нанорозмірних структур;
- гетероструктури у наноелектроніці;
- елементи функціональної наноелектроніки;
- самоорганізуючі структури для наноелектроніки;
- наноімпринтінг, мікро- і нанороботи;
- джерела та приймачі випромінювання на основі нанотехнологій;
- моделювання у наноелектроніці;
- електродинаміка та наноелектроніка ТГц і ГГц діапазонів;
- метаматеріали та їх застосування у наноелектроніці ТГц і ГГц діапазонів.

**Організаційний внесок** для публікації матеріалів конференції:

для учасників з України – **350 грн.**

для учасників з країн СНД - **25 Євро;**

для учасників з дальнього зарубіжжя – **50 Євро.**

Оргвнесок включає в себе видання програми, збірника наукових праць конференції, а також витрати, пов'язані з покриттям витрат на організацію та

проведення конференції, у тому числі витрати на рекламу, зв'язок, каву-брейк та інш.

Про прийняття Оргкомітетом доповідей та про банківські реквізити для перерахування коштів Ви будете повідомлені до 10 вересня 2017 р. у другому інформаційному листі.

**ВАЖЛИВІ ДАТИ:**

Подача матеріалів для публікації	08.09.2017
Повідомлення про прийняття матеріалів	10.09.2017
Рєєстрація, відкриття конференції.	18.09.2017

**ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ**

необхідно надати:

- Заяву (Додаток 1).
- Електронну версію доповіді (E-mail: [imd@nure.ua](mailto:imd@nure.ua)) однієї з робочих мов (англійська, українська, російська), яка оформлена у відповідності до вимог щодо оформлення доповіді та наданим зразком (Додаток 2).
- Акт експертної оцінки (для співробітників ХНУРЕ)

**ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ:**

- Обсяг – від 2-х до 4-х **повних** сторінок формату **A4**, набраного у текстовому редакторі Microsoft Word.
- Поля – **30** мм; абзацний відступ **1 см.**
- Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 11, інтервал між рядками – одинарний.
- Анотація на англійській мові (10-15 строк).
- Текст рукопису повинен бути структурований та включати всі *основні частини, характерні для опису наукового дослідження: вступ* (відображає *актуальність*, формулювання *мети* та *задач* дослідження); *суть* (викладення основного матеріалу дослідження з описом ідеї, методу та обґрунтуванням отриманих наукових результатів); *висновки* (відображають результати дослідження, їх *наукову новизну* та *практичну значущість*,

- порівняння з світовими аналогами, перспективи); повинен бути **перелік літератури** (до 5 джерел).
- Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті, повинні бути набрані як об'єкти Microsoft Equation.
  - Малюнки та таблиці повинні бути чіткими, компактними. Редактори: CorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.
  - Тексти доповідей друкуються у авторському варіанті без редагування.

#### **Порядок розміщення матеріалу:**

**НАЗВА ДОПОВІДІ** (великими буквами, жирно, по центру рядка).

Наступним рядком – прізвище, ініціали авторів по центру рядка.

Наступним рядком – повна назва організації по центру рядка.

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, E-mail організації або авторів.

Наступним рядком – анотація англійською мовою (10-15 рядків).

Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді.

#### **Додаток 1**

##### **Форма заявки:**

- Прізвище, ім'я, по-батькові авторів (повністю), учене звання, наукова ступінь, посада.
- Повна назва організації.
- Адреса для переписки з вказівкою індексу міста, факс, контактний телефон (з вказівкою коду),
- E-mail.
- Найменування наукового напрямку.
- Форма участі (з доповіддю, без доповіді).

#### **Додаток 2**

##### **ЗРАЗОК**

##### **СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ ОБ'ЄКТІВ**

Іванов І.І., Сергєєв М.О.

Харківський національний університет

радіоелектроніки

61166, Харків, пр. Науки, каф. системотехніки,

тел. (057) 702-13-06, факс (057) 702-11-13

E-mail: [ivanov@kture.kharkov.ua](mailto:ivanov@kture.kharkov.ua);

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used measuring etc. ... (10-15 рядків).

Текст доповіді ...

#### **АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:**

61166, м. Харків, просп. Науки, 14, ХНУРЕ, ІМВ (кімн. 437) К. т.:(057)702-13-97; Ф.: (057) 702-13-97; E-mail: [imd@nure.ua](mailto:imd@nure.ua)

#### **ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ**

##### ***Співголови:***

проф. Лепіх Я.І., проф. Сліпченко М.І.,  
проф. Тарапов С.І.

##### ***Члени програмного комітету:***

- Беляєв О.Є. – член-кор. НАН України, проф., директор Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна
- Бондаренко І.М. – проф., зав. каф. ХНУРЕ, м. Харків, Україна
- Вербицький В.Г. – проф. НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна
- Гордієнко Ю.О. – проф. ХНУРЕ, м. Харків, Україна
- Готра З.Ю. – проф., зав. каф. НТУ «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
- Гриньов Б.В. – академік НАН України, проф., зав. каф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м.Харків, Україна
- Зависляк І.В. – проф. Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, м.Київ, Україна
- Катрич В.А. - д.ф.-м.н., проф., проректор з наукової роботи ХНУ ім. В.Н.Каразіна, м.Харків, Україна
- Костильов В.П. – нач. лаб. Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна
- Осипов А. М. - проф., проректор з наукової роботи Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки, м. Мінськ, Білорусь
- Негрійко А.М. – член-кор. НАН України, заст. директора Інституту фізики НАН України, м. Київ, Україна
- Плаксін С.В. - д.ф.-м.н., с.н.с., зав. відділом Інституту транспортних систем та технологій НАН України, м.Дніпро, Україна
- Просвірнін С.Л. – проф. Радіоастрономічного інституту НАН України, м.Харків, Україна
- Сізов Ф.Ф. – член-кор. НАН України, проф. Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна
- Скришевський В.А. – проф., зав. каф. Інституту високих технологій Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, м. Київ, Україна
- Chichkov V.N. - Prof., Dr., Head of the Nanotechnology Department Laser Zentrum, Hannover, Germany
- Якименко Ю.І. – академік НАН України, проф., перший проректор НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна
- Ямпольський В.О. – член-кор. НАН України, проф. ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, м. Харків, Україна